PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-252489

(43) Date of publication of application: 09.09.1994

(51)Int.CI.

H01S 3/1055 H01S 3/085

H01S 3/18

(21)Application number: 05-062779

(71)Applicant: ANDO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

26.02.1993

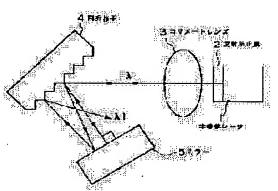
(72)Inventor: FUNAKAWA SEIJI

(54) EXTERNAL RESONATOR LASER

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an external resonator laser having an improved performance, by making the reduction of the return quantity of the beam returned to a semiconductor laser minimum when the diffracted beam from the diffraction grating is returned to the semiconductor laser, and by improving the wavelength resolution of the wavelength of the beam returned to the semiconductor laser.

CONSTITUTION: In the structure of an external resonator laser, a semiconductor laser 1, a reflection preventing film 2 applied to the semiconductor laser 1, a collimator lens 3 for collating the laser beam emitted from the semiconductor laser, a diffraction grating 4 for diffracting every wavelength the collimated laser beams and a mirror 5 which is so provided as to be vertical to the laser beam having a desired wavelength ε of the wavelengths of the diffracted laser beams are provided.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.08.1998

[Date of sending the examiner's decision of

10.07.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-252489

(43)公開日 平成6年(1994)9月9日

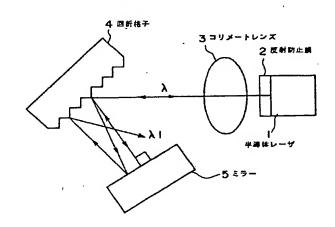
	3/1055 3/085	識別記号	庁内整理番号 8934-4M	FΙ	技術表示箇所			
	3/18		8934-4M	H 0 1 S	3/ 08		S	
				審査請求	未請求	請求項の数1	FD	(全 3 頁)
(21)出願番号		特願平5-62779		(71)出願人	000117744 安藤電気株式会社			
(22)出顧日		平成 5年(1993) 2	:月26日	(72)発明者	東京都定	大田区蒲田4丁 青次 大田区蒲田4丁		

(54) 【発明の名称】 外部共振器レーザ

(57)【要約】

【目的】 半導体レーザに回折格子からの回折光が戻る際の半導体レーザに戻る戻り光量の低下を最小限に押え、かつ半導体レーザへ戻る波長の波長分解能を上げることにより性能の向上をはかった外部共振器レーザを提供する。

【構成】 半導体レーザ1と半導体レーザ1に施された 反射防止膜2と、半導体レーザから出射されたレーザ光 を平行光とするコリメートレンズ3と、平行光とされた レーザ光を波長毎に分散させる回折格子4と、分散され たレーザ光の波長のうち所望の波長 λ に対して垂直に配置されたミラー5とを配置した構造とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも片側の共振器面に反射防止膜 (2) をコートした半導体レーザ(1) と、半導体レーザ

(1) の反射防止膜(2) をコートした面から出射されるレ ーザ光を平行光にするコリメートレンズ(3) と、平行光 にされた前記レーザ光に対してその波長により異なった 角度で回折を起こす回折格子(4) とを備えた外部共振器 レーザにおいて、

回折格子(4) により回折したレーザ光のうち所望の波長 の光に対して垂直に配置されたミラー(5)を設けること を特徴とする外部共振器レーザ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、コヒーレント光通 信、光通信用測定器等に使用される光源である外部共振 器レーザについてのものである。

[0002]

【従来の技術】つぎに、従来技術による外部共振器レー ザの構成を図2に示す。図2の1は半導体レーザ、2は 反射防止膜、3はコリメートレンズ、4は回折格子であ る。

【0003】図2で、半導体レーザ1の反射防止膜2が 施された面から出射されたレーザ光は、コリメートレン ズ3により平行光にされ、回折格子4へ入射する。回折 格子4に入射したレーザ光はその波長により異なった角 度で回折を起こす。回折を起こしたレーザ光のうち所望 の波長んがコリメートレンズ3を通して再び半導体レー ザ1に再入射するように回折格子4の角度を調整する と、所望の波長以外の波長(例えば 1 1)は半導体レー ザ1に戻ることなく外部共振器レーザは、所望の波長λ で発振させることができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】外部共振器レーザの波 長分解能は、レーザ光が含んでいる波長が回折格子4に より回折するときの所望の波長λとそのほかの波長(例 えばん1)の回折角の大きさにより決定される。すなわ ち、回折格子4によってレーザ光が回折を起すとき各波 長に対しての回折角の差が大きければ外部共振器の波長 分解能を髙めることができる。

【0005】しかし従来の外部共振器レーザの構成で は、波長間の回折角の差を大きくとるために2次の回折 光を利用した回折格子を使用したり、コリメートレンズ の焦点距離を大きくとることにより、回折格子から半導 体レーザへ回折光が入射する際の、波長間での結合効率 を調節していた。このような構成では、波長分解能を高 めることで、所望の波長λが半導体レーザに戻る戻り光 **虽が低下し、外部共振器レーザの光出力が低下しまた波** 長可変幅が狭くなる。

【0006】この発明は、外部共振器レーザにおいて、 半導体レーザに回折格子からの回折光が戻る際の半導体

レーザに戻る戻り光量の低下を最小限に押え、かつ半導 体レーザへ戻る波長の波長分解能を上げることにより、 外部共振器レーザの性能を向上させる外部共振器レーザ を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に、この発明では、半導体レーザ1から出射されコリメ ートレンズ2で平行光とされたレーザ光を回折格子4で 回折させ、所望の波長 λ が回折する方向にミラー 5 を垂 10 直に配置し、ミラー5により所望の波長 λを回折格子4 に再入射させて回折格子4で所望の波長1を再び回折さ せ、コリメートレンズ3を通して半導体レーザ1に所望 の波長を再入射させる。

[0008]

【作用】このように構成することにより、ミラー5から 反射した光は、回折格子 4 で再び回折が起こる。その時 所望の波長の光 λ は、回折格子 4 に最初に入射したとき と同一の軌跡を逆にたどってコリメートレンズ3で集光 され半導体レーザ1に戻される。所望の波長以外の光 (例えばん1) は、所望の波長んの光に対して分散角が 20 大きくなった状態で回折格子4で回折されるため、所望 の波長んに対して大きな分散角を持ってコリメートレン ズ3に入射する。そのため、所望の波長 λ とは異なる位 置で集光され、半導体レーザ1へ戻る波長の範囲が狭く 25 なる。

【0009】すなわち、外部共振器内で回折格子4を2 度通過させる機構により、半導体レーザ1に光が戻ると きの波長範囲を狭くすることが可能になる。

[0010]

30

【実施例】次に、この発明による外部共振器レーザの実 施例の構成をを図1に示す。図1の1は半導体レーザ、 2は反射防止膜、3はコリメートレンズ、4は回折格 子、5はミラーである。半導体レーザ1の無反射コート 2が施された面から出射されたレーザ光は、コリメート 35 レンズ3で平行光にされ回折格子4に入射する。回折格 子4に入射したレーザ光は回折格子4によって回折を起 し波長ごとに分解される。

【0011】ここでミラー5は、回折格子4から回折し た光のうち所望の波長λに対して垂直になるよう配置さ 40 れ、所望の波長λがミラー5に入射したのと同一の軌跡 をたどって回折格子4に戻ることになる。そして所望の 波長以外の波長 (例えばλ1) の光はミラー5に対して 垂直よりも浅く、もしくは深い角度で入射するため、ミ ラー5で回折格子4の方向に反射されたときには、所望 45 の波長の光に対する他の波長の光の分散角が大きくな

【0012】例えば、半導体レーザ1として1.55_μ mファブリペロー型半導体レーザを用い、半導体レーザ 1の片端面にはSi N_x の反射防止膜2を施こす。コリ 50 メートレンズ3はセルフォックレンズ、回折格子4は

1. 4 μ m から 1. 6 μ m までの波長範囲で高い回折効 率をもち、ミラー5は 2/4以上の平面度を持った平面 ミラーを用いる。回折格子4はレーザ光が当る部分を中 心に回転する回転機構を備え、半導体レーザ1に戻る光 の波長は、回折格子4の回転角によって決まるように構 05 成図である。 成する。

[0012]

【発明の効果】この発明によれば、半導体レーザから出 射されコリメートレンズによって平行光とされたレーザ 光が回折格子とミラーとによって所望の波長λに対する 他の波長(例えばん1)の分散角を大きくし、半導体レ ーザへ戻る戻り光量を低下させることなく波長分解能を

髙めることができ、外部共振器レーザの特性を向上させ ることができる。

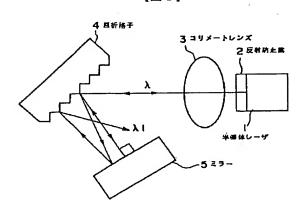
【図面の簡単な説明】

【図1】この発明による外部共振器レーザの実施例の構

【図2】従来の外部共振器レーザの構成図である。 【符号の説明】

- 1 半導体レーザ
- 2 反射防止膜
- 10 3 コリメートレンズ
 - 4 回折格子
 - 5 ミラー

【図1】



[図2]

